

新機能薄膜開発に・・・
次世代表面保護膜開発に・・・

特許第3865570号

R&D用
新型PVD装置

スパッタやプラズマCVDでは得られない高品質膜を実現！

クリーン真空アークプラズマを用いた リアルイオンプレーティング

小型フィルタードアーク蒸着装置 (マイクロ ティー・ファッド)

μT-FAD

Micro T-shape Filtered Arc Deposition system

- 各種DLC膜 (ta-C*1, a-C, ta-C:H, a-C:H); 水素フリー & 含有
- Si含有DLC, N含有DLC, ポリマーDLC
- 金属膜, 合金膜・・・ガス導入不要
- 窒化物, 酸化物, その他化合物膜
- 反応性成膜可能
- ドロップレットフリー*2
- 超平滑膜形成
- 超薄膜形成

主な仕様

アーク電流: DC30 A ~ 150 A
陰極*3: 30 ~ 58 mmφ × 5 mm
水冷ダクト
ダクトバイアス付き
基板サイズ: 30 mmφ
イオン電流モニタ可
ガス導入可
その他, 応相談可



New!

豊橋技術科学大学 電気・電子工学系
滝川浩史教授との共同開発品です。

*1テトラヘドラルDLC; スーパーDLC (~ 70 GPa).
*2生産用T-FADよりドロップレット除去効率は低いです。
*3スパッタでいうターゲット(蒸発物質): 非導電性物質は利用できません。